

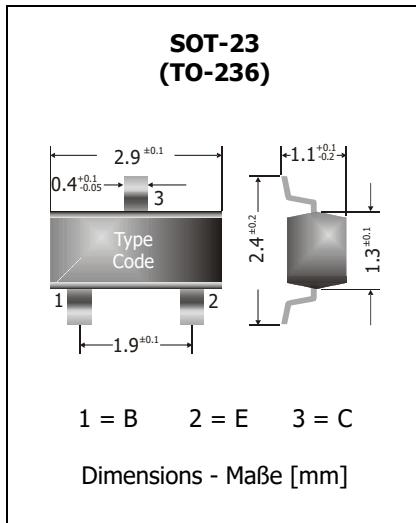
DI13001

SMD High Voltage NPN Transistors
SMD Hochspannungs-NPN-Transistoren

$I_C = 250 \text{ mA}$
 $h_{FE1} = 10 \dots 40$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = 700 \text{ V}$
 $P_{tot} = 800 \text{ mW}$

Version 2019-12-17

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

High collector-emitter voltage
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 3000 / 7"
 Weight approx. 0.01 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

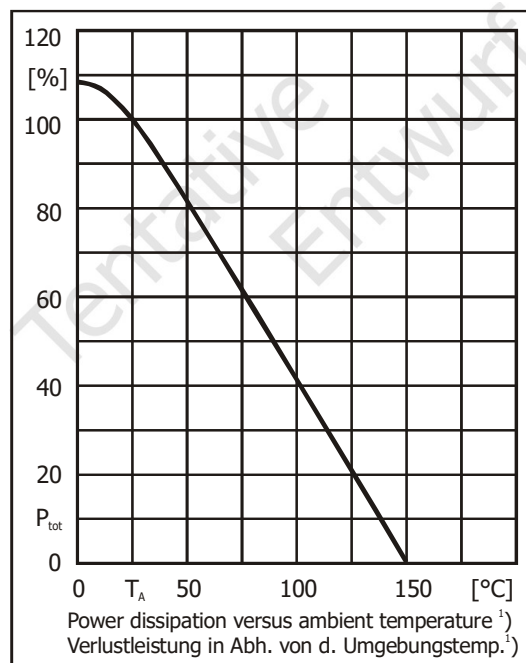
**Maximum ratings ²⁾****Grenzwerte ²⁾**

			DI13001
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B-E short	V_{CES}	700 V
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	450 V
Emitter-Base-voltage Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	6 V
Power dissipation Verlustleistung		P_{tot}	800 mW ³⁾
Collector current Kollektorstrom	DC	I_C	250 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
$I_C = 50\text{ mA}$ $I_C = 1\text{ mA}$	$V_{CE} = 5\text{ V}$ ¹⁾	h_{FE}	10 10	–	40 –
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung					
$I_C = 100\text{ mA}$	$I_B = 20\text{ mA}$ ¹⁾	V_{CEsat}	–	–	0.6 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung					
$I_C = 100\text{ mA}$	$I_B = 20\text{ mA}$ ¹⁾	V_{BEsat}	–	–	1.5 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
$V_{CB} = 700\text{ V}$	B-E short	I_{CES}	–	–	10 μA
Switching times – Schaltzeiten					
$I_C = 100\text{ mA}$	resistive load	t_r t_s	– 0.8 μs	– –	1 μs 3.5 μs
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	156 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
 2 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NTE158](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE63](#) [C4460](#)
[2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2369ADCSM](#)
[2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC5490A-TL-H](#) [2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CMXT3906 TR](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3583](#) [NTE103](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE101](#) [NTE13](#) [NTE15](#) [NTE16001](#) [NTE16006](#)
[NTE26](#)